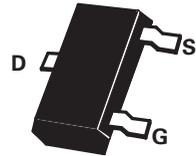


# SOT23 N-CANNEL ENHANCEMENT MODE VERTICAL DMOS FET

ISSUE 3 – JANUARY 1996 

## BSS123

PARTMARKING DETAIL – SA



SOT23

### ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS.

PARAMETER	SYMBOL	VALUE	UNIT
Drain-Source Voltage	$V_{DS}$	100	V
Drain-Gate Voltage	$V_{DGR}$	100	V
Continuous Drain Current at $T_{amb}=25^{\circ}C$	$I_D$	170	mA
Pulsed Drain Current	$I_{DM}$	680	mA
Gate-Source Voltage	$V_{GS}$	$\pm 20$	V
Peak Gate-Source Voltage	$V_{GSM}$	$\pm 20$	V
Power Dissipation at $T_{amb}=25^{\circ}C$	$P_{tot}$	360	mW
Operating and Storage Temperature Range	$T_j; T_{stg}$	-55 to +150	$^{\circ}C$

### ELECTRICAL CHARACTERISTICS (at $T_{amb} = 25^{\circ}C$ unless otherwise stated).

PARAMETER	SYMBOL	MIN.	MIN.	MAX.	UNIT	CONDITIONS.
Drain-Source Breakdown Voltage	$BV_{DSS}$	100			V	$I_D=0.25mA, V_{GS}=0V$
Gate-Source Threshold Voltage	$V_{GS(th)}$	0.8	2.2	2.8	V	$I_D=1mA, V_{DS}=V_{GS}$
Gate-Body Leakage	$I_{GSS}$		10	50	nA	$V_{GS}=\pm 20V, V_{DS}=0V$
Zero Gate Voltage Drain Current	$I_{DSS}$		1	15	$\mu A$	$V_{DS}=100V, V_{GS}=0V$
			2	60	$\mu A$	$V_{DS}=100V, V_{GS}=0V, T=125^{\circ}C(2)$
				10	nA	$V_{DS}=20V, V_{GS}=0V$
Static Drain-Source On-State Resistance (1)	$R_{DS(on)}$		5	6	$\Omega$	$V_{GS}=10V, I_D=100mA$
Forward Transconductance(1)(2)	$g_{fs}$	80	120		mS	$V_{DS}=25V, I_D=100mA$
Input Capacitance (2)	$C_{iss}$			20	pF	$V_{DS}=25V, V_{GS}=0V, f=1MHz$
Common Source Output Capacitance (2)	$C_{oss}$			9	pF	
Reverse Transfer Capacitance (2)	$C_{rss}$			4	pF	
Turn-On Delay Time (2)(3)	$t_{d(on)}$		10		ns	$V_{DD} \approx 30V, I_D=280mA$
Rise Time (2)(3)	$t_r$		10		ns	
Turn-Off Delay Time (2)(3)	$t_{d(off)}$		15		ns	
Fall Time (2)(3)	$t_f$		25		ns	

(1) Measured under pulsed conditions. Width=300 $\mu s$ . Duty cycle  $\leq 2\%$  (2) Sample test.

(3) Switching times measured with 50 $\Omega$  source impedance and <5ns rise time on a pulse generator For typical characteristics graphs see ZVN3310F datasheet.

## Данный компонент на территории Российской Федерации

### Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9